รายการอ้างอิง

[1] A. Marty ; " Sur l'étude des transistors bipolaires à hétérojonction GaAlAs-GaAs. Théorie et expérience " ; Thesis of Doctorat d' Etat (Science), n° 931, Université Paul Sababier, Toulouse, June 1980.

[2] Kroemer Herbert ; " Heterostructure Bipolar Transistor and Integrated Circuits " ; Proceeding of the IEEE, Vol 70, No. 1 January 1982.

[3] J.P. Bailbe, A. Marty, G. Rey, J. Tasselli, and A.Bouyahyaoui ; " Electrical Behavior of Double Heterojunction NpN GaAlAs/GaAs/GaAlAs Bipolar Transistors " ; Solid-State Electronics Vol. 28, No. 6, 1985: pp. 627-638.

[4] S. L. Su, O. Tejayadi, T. J. Drummond, R. Fischer, and H. Morkoc ; " Double Heterojunction $Al_xGa_{1-x}As$/GaAs Bipolar Transistors (DHBJTs) by MBE with a Current Gain of 1650 " ; Proceeding of the IEEE, 1983: pp. 130-132.

[5] Hasan H. Erkaya, and Ronald J. Roedel ; " Difficulties in the Fabrication of Planar GaAlAs/GaAs Heterojunction Bipolar Transistors " ; Proceeding of the IEEE, 1991: pp. 973-976.

[6] ชุมพล อันตรเสน, มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร, บรรยง โตประเสริฐพงศ์, ธารา ชลปราณี ; " รายงานการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โครงการออปโตอิเล็กทรอนิกส์ " ; ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

[7] Y-R Yuan, Kazuo Eda, G. Allen Vawter, and James L. Merz ; " Open tube diffusion of Zn into AlGaAs and GaAs " ; J. Appl. Phys., Vol. 54, October 1983: pp.6044-6046.

[8] S.B. Phatak ; " An Open Tube Method of Zn Diffusion in III-V Compounds " ; Proceeding of the IEEE Electron Device Letters, Vol. EDL-3, No. 5, May 1982: pp.132-134.

[9] J.M. Woodall and H.J. Hovel ; " LPE Growth of GaAs-$Ga_{1-x}Al_xAs$ Solar Cells " ; Journal of Crystal Growth 39, North-Holland Publishing Company, 1977: pp. 108-116.

[10] ชุมพล อันตรเสน, ศุภโชค ไทยน้อย, สมภพ อัษฎมงคล, สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ; " การผลิตทรานซิสเอตร์สองหัวต่อสำหรับวงจรร่วม GaAs " ; การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 20, พ.ศ. 2540: pp. 491-494.

[11] ยุพาวดี ดีสิรพิพัฒน์ ; " การพัฒนาทรานซิสเตอร์ชนิดหัวต่อต่างชนิด 2 หัวต่อในวงจรรวมของแกลเลียมอาร์เซไนด์ " ; Senior Project ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีการศึกษา 2540.

[12] R. J. Malik, J. R. Hayesm F. Capasso, K. Alavi, and A. Y. Cho ; " High-Gain $Al_{0.48}In_{0.52}As/Ga_{0.53}As$ Vertical n-p-n Heterojunction Bipolar Transistors Grown by Molecular-Beam Epitaxy " ; Proceeding of the IEEE, 1983: pp. 383-385.

[13] C. Antarasena, S. Panyakeow, and S. Thainoi ; " Fabrication of Ga0.6Al0.4As/GaAs Heterojunction Bipolar Transistors " ; 2nd RSOE, 1989: pp.112-115.

[14] A. C. Han, M. Wojtowicz, T. R. Block, X. Zhang, T.P. Chin, A. Cavus, A. Oki, and D. C. Streit ; " Characterization of GaAs/AlGaAs heterojunction bipolar transistor devices using photoreflectance and photoluminescence " ; Journal of Applied Physics, Vol. 86, No. 11, 1 December 1999: pp.6160-6163.

[15] Wen-Chau Liu, Der-Feng Guo, and Wen-Shiung Lour ; " AlGaAs/GaAs Double-Heterostructure-Emitter Bipolar Transistor (DHEBT) " ; Proceeding of the IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 39, No. 12, December 1992: pp. 2740-2744.

[16] P. M. Asbeck, D. L. Miller, W. C. Petersen, and C. G. Kirkpatrick ; " GaAs/GaAlAs Heterojunction Bipolar Transistors with Cutoff Frequencies Above 10 GHz " ; Proceeding of the IEEE Electron Device Letters, Vol. EDL-3, No. 12, December 1982: pp. 366-368.

[17] H. Kroemer ; " Double Heterojunction NpN GaAlAs/GaAs Bipolar Transistor " ; Electronics Letters, Vol. 18, No. 1, ED-25, 7th January 1982 : pp. 25-27.

[18] P. M. Asbeck, D. L. Miller, R. Asatourian, and C. G. Kirkpatrick ; " Numerical Simulation of GaAs/GaAlAs Heterojunction Bipolar Transistors " ; Proceeding of the IEEE Electron Device Letters, Vol. EDL-3, No. 12, December 1982: pp.403-406.

[19] W. V. McLevige, H. T. Yuan, W. M. Duncan, W. R. Frensley, F. H. Doerbeck, H. Morkoc, and T. J. Drummond ; " GaAs/AlGaAs Heterojunction Bipolar Transistors for Integrated Circuit Applications " ; Proceeding of the IEEE Electron Device Letters, Vol. EDL-3, No. 2, 1982: pp. 452-455.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ : นางสาว ยุพาวดี ดีสิรพิพัฒน์

ที่อยู่ปัจจุบัน : 475/62 ซอยพระยาสิงห์ ถนนพระราม4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 2151137

เกิดเมื่อวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2519

การศึกษา : พ.ศ. 2534-2537 มัธยมต้น
โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2535-2537 มัธยมปลาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2537-2541 วศ.บ. ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวหรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. 2541-2543 เข้าศึกษาหลักสูตร ปริญญาโท
สาขาสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย